SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER TRANSISTOR

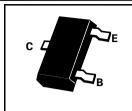
FMMT489

ISSUE3 - OCTOBER 1995

FEATURES

* Very low equivalent on-resistance; $R_{CE(sat)}$ 175m Ω at 1A

COMPLEMENTARY TYPE – FMMT589 PARTMARKING DETAIL – 489



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V _{CEO}	30	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	5	V
Continuous Collector Current	Ic	1	Α
Peak Pulse Current	I _{CM}	4	Α
Base Current	I _B	200	mA
Power Dissipation at T _{amb} =25°C	P _{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	T _i :T _{stq}	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at Tamb = 25°C).

		<u> anno</u>			
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Breakdown Voltages	V _{(BR)CBO}	50		V	I _C =100μA
	V _{CEO(sus)}	30		V	I _C =10mA*
	V _{(BR)EBO}	5		V	I _E =100μA
Collector Cut-Off Current	I _{CBO}		100	nA	V _{CB} =30V
	I _{CES}		100	nA	V _{CES} =30V
Emitter Cut-Off Current	I _{EBO}		100	nA	V _{EB} =4V
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}		0.3 0.6	V	I _C =1A, I _B =100mA* I _C =2A, I _B =200mA*
Base-Emitter Saturation Voltage	V _{BE(sat)}		1.1	V	I _C =1A, I _B =100mA*
Base-Emitter Turn On Voltage	V _{BE(on)}		1.0	V	I _C =1A, V _{CE} =2V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h _{FE}	100 100 60 20	300		I _C =1mA, V _{CE} =2V* I _C =1A, V _{CE} =2V* I _C =2A, V _{CE} =2V* I _C =4A, V _{CE} =2V*
Transition Frequency	f _T	150		MHz	I _C =50mA, V _{CE} =10V f=100MHz
Collector-Base Breakdown Voltage	C _{obo}		10	pF	V _{CB} =10V, f=1MHz

^{*}Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤ 2% For typical characteristics graphs see FMMT449 datasheet

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru 4 moschip.ru 9